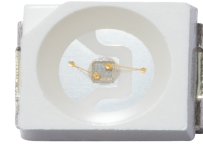


UV-B 센서

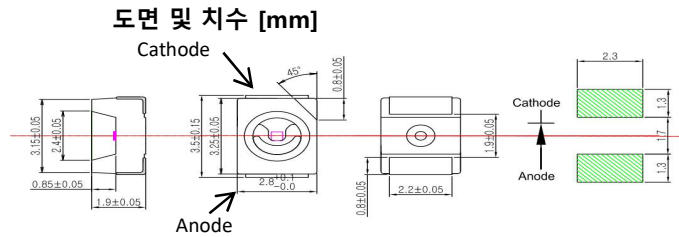
GUVB-S11SD



- 특징**
- 알루미늄 질화갈륨 기반의 물질
 - 쇼트키 타입 광다이오드
 - 광기전성 모드 동작
 - 우수한 가시광 차단성
 - 높은 광 반응도와 낮은 누설전류



- 적용** 자외선 인덱스 감지



절대 최대 평가

항목	기호	최소값	최대값	단위	비고
저장 가능 온도	T_{st}	-40	90	°C	
동작 가능 온도	T_{op}	-30	85	°C	
역방향 전압	$V_{r, max.}$		3	V	
순방향 전압	$I_{f, max.}$		1	mA	
측정 광량 범위	P_{opt}	0.01	100	mW/cm ²	UVB Lamp
납땀 온도	T_{sol}		260	°C	10초 이내

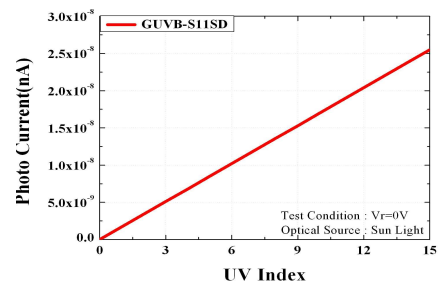
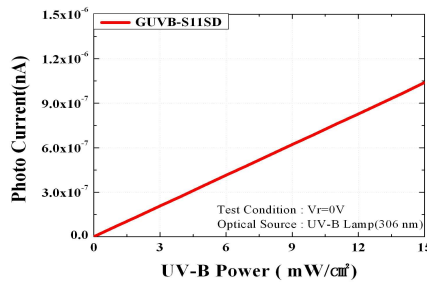
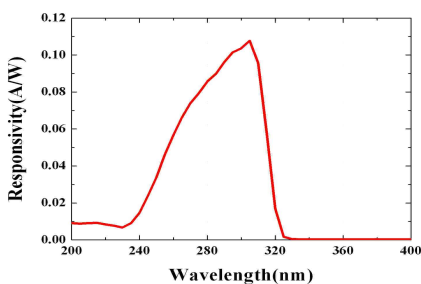
※참고:광원의 세기가 100mW/cm²보다 큰 경우, 센서의 수명을 위해 감쇠기를 사용 또는 문의주시기 바랍니다.

특성 (25°C 상온)

항목	기호	최소값	대표값	최대값	단위	시험 조건
암전류	I_d			1	nA	$V_r = 0.1 V$
광전류	I_{ph}	62	69	76	nA	UVB Lamp, 1mW/cm ²
			1.4		nA	1 UVI
온도 계수	I_{tc}		0.1		%/°C	UVB Lamp
반응도	R		0.11		A/W	$\lambda = 300 nm, V_r = 0 V$
감지 파장 영역	λ	240		320	nm	10% of R
활성 영역			0.076		mm ²	

반응도 곡선

자외선 광량에 따른 광전류 변화



주의

정전기로 인해 제품이 손상될 수 있으므로, 정전기에 주의하시기 바랍니다.